

ペロブスカイト太陽電池の業界ガイドライン

Guidelines for Perovskite photovoltaic (PV) modules

2026年(令和8年)3月25日制定



一般社団法人日本電機工業会

目次

ページ

1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 供試体	2
5 要求事項	2
5.1 一般	2
5.2 発電性能	2
5.3 設計要求	2
5.4 安全要求	2
6 試験	3
6.1 試験フロー	3
6.2 発電性能	5
6.2.1 目視検査 (MST 01/MQT 01)	5
6.2.2 最大出力の決定 (MSPT 03/MQPT 02)	5
6.2.3 絶縁試験 (MST 16/MQT 03)	5
6.2.4 温度依存性の測定 (MQPT 04)	5
6.2.5 基準状態 (STC) における性能試験 (MSPT 02/MQPT 06.1)	6
6.2.6 低放射照度における性能試験 (MQT 07)	6
6.2.7 屋外暴露試験 (MQT 08)	6
6.2.8 ホットスポット耐久試験 (MST 22/MQT 09)	6
6.2.9 紫外線前処理試験 (MQT 10)	6
6.2.10 温度サイクル試験 (MQT 11)	6
6.2.11 結露凍結試験 (MQT 12)	6
6.2.12 高温高湿試験 (MQT 13)	6
6.2.13 端子強度試験 (MSPT 42/MQPT 14)	6
6.2.14 湿潤漏れ電流試験 (MQT 15)	6
6.2.15 機械的静荷重試験 (MQPT 16)	6
6.2.16 降ひょう (雹) 試験 (MQPT 17)	7
6.2.17 バイパスダイオード試験 (MQT 18)	7
6.2.18 安定化 (MQPT 19)	7
6.2.18.1 安定化の基準	7
6.2.18.2 光照射安定化法	7
6.2.18.3 初期安定化 (MQPT 19.1)	7
6.2.18.4 最終安定化 (MQPT 19.2)	7

6.2.19	機械的動荷重サイクル試験 (MQT 20)	7
6.2.20	電圧誘起劣化 (PID) 試験 (MQT 21)	7
6.2.21	曲げ試験 (MQPT 22)	7
6.2.21.1	手順	8
6.3	設計要求	8
6.3.1	電気部品及び絶縁物	8
6.3.2	機械的及び電気機械的接続	8
6.3.3	材料	8
6.3.4	感電防止	8
6.4	安全要求	8
6.4.1	一般	8
6.4.2	環境ストレス試験	8
6.4.2.1	温度サイクル試験 (MST 51/MQT 11)	8
6.4.2.2	結露凍結試験 (MST 52/MQT 12) (HF 10)	8
6.4.2.3	高温高湿試験 (MST 53/MQT 13) (DH200 or DH1000)	9
6.4.2.4	UV 試験 (MST 54/MQT 10)	9
6.4.2.5	低温処理試験 (MST 55)	9
6.4.2.6	乾燥高温処理試験 (MST 56)	9
6.4.3	一般検査	9
6.4.3.1	目視検査 (MST 01/MQT 01)	9
6.4.3.2	基準状態 (STC) における性能試験 (MSPT 02/MQPT 06)	9
6.4.3.3	絶縁層の厚さ試験 (MST 04)	9
6.4.3.4	表示の耐久性試験 (MST 05)	9
6.4.3.5	シャープエッジ試験 (MST 06)	9
6.4.3.6	バイパスダイオード機能試験 (MST 07/MQT 18.2)	9
6.4.4	感電危険試験	9
6.4.4.1	接近性試験 (MST 11)	9
6.4.4.2	切断性試験 (MST 12)	10
6.4.4.3	等電位ボンディング連続性試験 (MST 13)	10
6.4.4.4	インパルス電圧試験 (MST 14)	10
6.4.4.5	絶縁試験 (MST 16/MQT 03)	10
6.4.4.6	湿潤漏れ電流試験 (MST 17/MQT 15)	10
6.4.4.7	端子強度試験 (MSPT 42/MQPT 14)	10
6.4.5	耐火性試験	10
6.4.5.1	ホットスポット耐久試験 (MSPT 22/MQPT 09)	10
6.4.5.2	火災試験 (MSPT 23)	10
6.4.5.3	着火性試験 (MSPT 24)	10
6.4.5.4	バイパスダイオード温度試験 (MSPT 25/MQPT 18.1)	10
6.4.5.5	逆電流過負荷試験 (MSPT 26)	10
6.4.6	機械的ストレス試験	10

6.4.6.1	衝撃破壊試験 (MSPT 32)	10
6.4.6.2	ねじ込み式接続試験 (MSPT 33)	11
6.4.6.3	機械的静荷重試験 (MSPT 34/MQPT 16)	11
6.4.6.4	剥離試験 (MSPT 35)	11
6.4.6.5	せん断強度試験 (MSPT 36)	11
6.4.6.6	材料クリープ試験 (MSPT 37)	11
6.4.6.7	端子強度試験 (MSPT 42/MQPT 14)	11
7	表示及び文書類	11
8	サンプリング	12
9	試験の実施	12
	附属書 A (参考) 試験シーケンス用 PV モジュール識別子	13

ペロブスカイト太陽電池の業界ガイドライン

Guidelines for Perovskite photovoltaic (PV) modules

1 適用範囲

この文書は、長期運転に適した建物・地上設置のペロブスカイト太陽電池 (PV) モジュール (以下, PV モジュールと記載) の発電性能評価, 設計要求事項, 安全要求事項及び製品ラベルについて規定する。

この文書は、発電層がペロブスカイトであり、外装材にフィルム又はガラスを使用し、軽量 (重量: 3kg/m² 以下) かつ、施工前の製品状態で曲げることが可能 (フレキシブル・ベンダブル) な PV モジュールに適用する。

ここで実施する一連の試験目的は、PV モジュールの電気特性を決定し、かつ、PV モジュールが一般的な屋外の気候下での耐久性並びに安全性を確認することである。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この文書に引用されることによって、規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

JIS C 8960 太陽光発電用語

JIS C 8993 太陽電池 (PV) モジュール用火災試験方法

JIS C 61215-1 地上設置の太陽電池 (PV) モジュール-設計適格性確認及び型式認証 - 第1部: 試験要求事項

注記 対応国際規格における引用規格: **IEC 61215-1**, Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements

JIS C 61215-2 地上設置の太陽電池 (PV) モジュール-設計適格性確認及び型式認証 - 第2部: 試験方法

注記 対応国際規格における引用規格: **IEC 61215-2**, Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures

IEC 61730-1, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction

IEC 61730-2, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing

IEC TS 62915, Photovoltaic (PV) modules - Type approval, design and safety qualification -- Retesting

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、**JIS C 8960**, **JIS C 61215** 規格群及び **JIS C 61730**

規格群による。

3.1

フレキシブル PV モジュール

JIS C 61215-1 の 3.6 [フレキシブル PV モジュール (flexible module)] の規定を参照し、製造業者の仕様に従い、少なくとも一つの方向に 500 mm 以下の曲率半径を示す、曲面に応じて曲率半径を変えられる取付け支持体を含まない PV モジュール

注釈 1 仕様に記載のなき方向及びねじり方向は除外する。

3.2

超フレキシブル PV モジュール

この文書の 3.1 の規定のうち、150mm 以下の特に小さな曲率半径を示す PV モジュール

3.3

ベンダブル PV モジュール

製造業者の仕様に従い、少なくとも一つの方向に製造業者の定める 500 mm を超える有限の曲率半径を示し、曲面に応じて曲げることが可能な取付け支持体を含まない PV モジュール

注釈 1 仕様に記載のない方向及びねじり方向は除外する。

4 供試体

JIS C 61215-1 の箇条 4 (供試体) を変更なしで適用する。

5 要求事項

5.1 一般

この文書の 5.2～5.4 を全て満たす PV モジュールを合格と判定する。

5.2 発電性能

この文書の 6.2 の各試験を行い、JIS C 61215-1 の箇条 7 (合格基準) を次の規定とともに適用する。

各試験シーケンス終了後、又はシーケンス F [シーケンス B (61215)] の場合はバイパスダイオード温度試験後の各モジュールの最大出力 (ゲート No2) の低下は、初期出力 (ゲート No1) に対して 10%未満であること。

出力低下の数値に応じて、クラス A (5%未満)、クラス B (5%以上 10%未満) に分類する。

5.3 設計要求

この文書の 6.3 の試験を行い、IEC 61730-1 の箇条 5 (Classification, applications and intended use) を変更なしで適用する。

5.4 安全要求

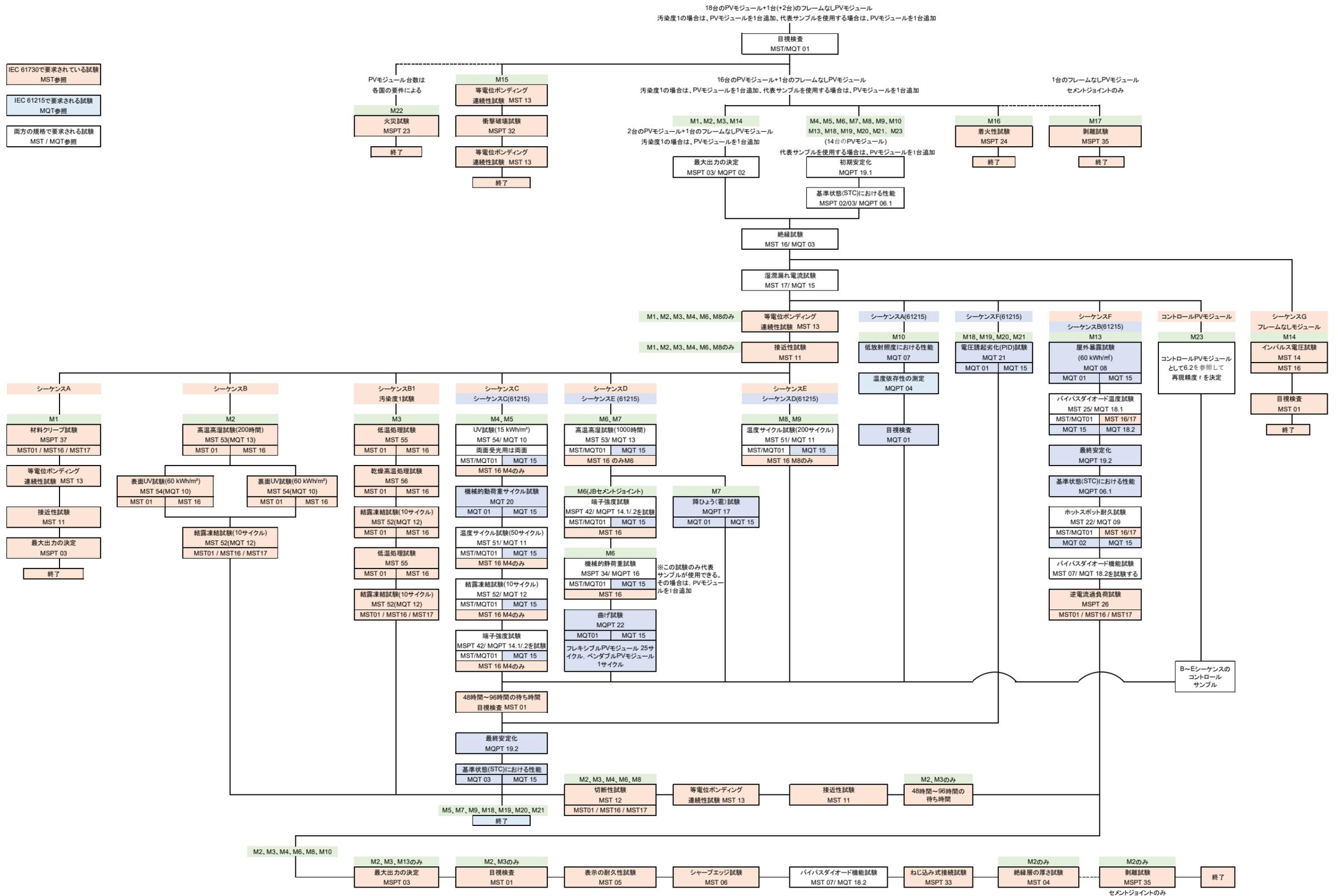
この文書の 6.4 の試験を行い、IEC 61730-2 の箇条 9 (Pass criteria) を変更なしで適用する。

6 試験

6.1 試験フロー

IEC TS 62915 に規定されている試験フロー及び試験方法の一部を変更して適用する (図 1 参照)。

- IEC 61730で要求されている試験
MST参照
- IEC 61215で要求される試験
MQT参照
- 両方の規格で要求される試験
MST / MQT参照



注記 M1, M2, M3...は附属書 A による。

図 1 - 試験フロー

6.2.5 基準状態 (STC) における性能試験 (MSPT 02/MQPT 06.1)

IEC 61730-2 の 10.3 [Performance at STC (MST02)] 又は JIS C 61215-2 の 4.6 [基準状態 (STC) における性能 (MQT 06.1)] を次の規定とともに適用する。

MPPT 方式を使用して決定してもよい。

この文書の 6.2.18 の処理後は、PV モジュールに光照射を継続してもよい。

6.2.6 低放射照度における性能試験 (MQT 07)

JIS C 61215-2 の 4.7 [低放射照度における性能 (MQT 07)] を変更なしで適用する。

6.2.7 屋外暴露試験 (MQT 08)

JIS C 61215-2 の 4.8 [屋外暴露試験 (MQT 08)] を変更なしで適用する。

6.2.8 ホットスポット耐久試験 (MST 22/MQT 09)

IEC 61730-2 の 10.16 [Hot-spot endurance test (MST 22)] 又は JIS C 61215-2 の 4.9 [ホットスポット耐久試験 (MQT 09)] を変更なしで適用する。

6.2.9 紫外線前処理試験 (MQT 10)

JIS C 61215-2 の 4.10 [紫外線前処理試験 (MQT 10)] を変更なしで適用する。

6.2.10 温度サイクル試験 (MQT 11)

JIS C 61215-2 の 4.11 [温度サイクル試験 (MQT 11)] を変更なしで適用する。

6.2.11 結露凍結試験 (MQT 12)

JIS C 61215-2 の 4.12 [結露凍結試験 (MQT 12)] を変更なしで適用する。

6.2.12 高温高湿試験 (MQT 13)

JIS C 61215-2 の 4.13 [高温高湿試験 (MQT 13)] を変更なしで適用する。

6.2.13 端子強度試験 (MSPT 42/MQPT 14)

IEC 61730-2 の 10.27 [Robustness of terminations test (MST 42)] 又は JIS C 61215-2 の 4.14 [端子強度試験 (MQT 14)] を次の規定とともに適用する。

製造業者の仕様に従い、取付け支持体への接着又は取付方法に従い実施してもよい。接着又は取付方法が二種類以上の場合、最も厳しい環境下にて試験を実施する。

6.2.14 湿潤漏れ電流試験 (MQT 15)

JIS C 61215-2 の 4.15 [湿潤漏れ電流試験 (MQT 15)] を変更なしで適用する。

6.2.15 機械的静荷重試験 (MQPT 16)

JIS C 61215-2 の 4.16 [機械的静荷重試験 (MQT 16)] を次の規定とともに適用する。

製造業者の仕様に従い、取付け支持体への接着又は取付方法に従い実施してもよい。接着又は取付方法が二種類以上の場合、最も厳しい環境下にて試験を実施する。

6.2.16 降ひょう（雹）試験（MQPT 17）

JIS C 61215-2 の 4.17 [降ひょう（雹）試験（MQT 17）] を次の規定とともに適用する。

製造業者の仕様に従い、取付け支持体への接着又は取付方法に従い実施してもよい。接着又は取付方法が二種類以上の場合、最も厳しい環境下にて試験を実施する。

6.2.17 バイパスダイオード試験（MQT 18）

JIS C 61215-2 の 4.18 [バイパスダイオード試験（MQT 18）] を変更なしで適用する。

6.2.18 安定化（MQPT 19）

JIS C 61215-2 の 4.19 [安定化（MQT 19）] を次の規定とともに適用する。

6.2.18.1 安定化の基準

JIS C 61215-2 の 4.19 [安定化（MQT 19）] による安定化の基準として、JIS C 61215-1-2, JIS C 61215-1-3, JIS C 61215-1-4 を参照し、 $x=0.02$ を使用する。

6.2.18.2 光照射安定化法

JIS C 61215-2 の 4.19.3（光照射安定化法）を変更なしで適用する。

6.2.18.3 初期安定化（MQPT 19.1）

JIS C 61215-2 の 4.19.5 [初期安定化（MQT 19.1）] を次の規定とともに適用する。

JIS C 61215-2 の 4.19 [安定化（MQT 19）] の要求事項を満たすには、初期及び以降 5kWh/m^2 以上の一定積算照射量の測定を 1 サイクルとし、合計 2 サイクル以上ソーラーシミュレータ又は太陽光にさらすことよって行う。この初期安定化処理後、全ての供試体に対し、JIS C 61215-2 の 4.6 [基準状態（STC）における性能（MQT 06.1）] を実施する。

6.2.18.4 最終安定化（MQPT 19.2）

JIS C 61215-2 の 4.19.6 [最終安定化（MQT 19.2）] を、この文書の 6.2.18.3 の変更内容とともに適用する。

6.2.19 機械的動荷重サイクル試験（MQT 20）

JIS C 61215-2 の 4.20 [機械的動荷重サイクル試験（MQT 20）] を変更なしで適用する。

6.2.20 電圧誘起劣化（PID）試験（MQT 21）

JIS C 61215-2 の 4.21 [電圧誘起劣化（PID）試験（MQT 21）] を変更なしで適用する。

6.2.21 曲げ試験（MQPT 22）

JIS C 61215-2 の 4.22 [曲げ試験（MQT 22）] を次の規定とともに適用する。

この試験は、フレキシブル・ベンダブル PV モジュールいずれも実施し、曲げ範囲は、製造業者の仕様に従う。

6.2.21.1 手順

JIS C 61215-2 の 4.22.3（手順）の b)～d)を次のように変更して適用する。

- b) PV モジュールを、平たん（坦）／平面の開始位置から規定の曲率半径のシリンダに沿わせる。PV モジュールが十分に大きい場合は、360°を超えて沿わせず、かつ、曲げ範囲全体を試験しなければならない。
- c) PV モジュールを、平たん（坦）／平面の開始位置まで戻す。
- d) b)及び c)をフレキシブル PV モジュールは 25 回繰り返し、ベンダブル PV モジュールは 1 回だけとする。

6.3 設計要求

6.3.1 電気部品及び絶縁物

IEC 61730-1 の 6.3（Electrical components and insulation）を変更なしで適用する。

6.3.2 機械的及び電気機械的接続

IEC 61730-1 の 6.4（Mechanical and electromechanical connections）を変更なしで適用する。

6.3.3 材料

IEC 61730-1 の 6.5（Materials）を変更なしで適用する。

6.3.4 感電防止

IEC 61730-1 の 6.6（Protection against electric shock）を変更なしで適用する。

6.4 安全要求

6.4.1 一般

以降の試験は、製造業者の仕様に従い、取付け支持体への接着又は取付方法に従い実施してもよい。接着又は取付方法が二種類以上の場合、最も厳しい環境下にて試験を実施する。

6.4.2 環境ストレス試験

IEC 61730-2 の 4.2（Environmental stress tests）を変更なしで適用する。

6.4.2.1 温度サイクル試験（MST 51／MQT 11）

IEC 61730-2 の 10.28 [Thermal cycling test (MST 51)] を変更なしで適用する。

6.4.2.2 結露凍結試験（MST 52／MQT 12）（HF 10）

IEC 61730-2 の 10.29 [Humidity-freeze test (MST 52)] 又は JIS C 61215-2 の 4.12 [結露凍結試験（MQT 12）] を変更なしで適用する。

6.4.2.3 高温高湿試験 (MST 53/MQT 13) (DH200 or DH1000)

IEC 61730-2 の 10.30 [Damp heat test (MST 53)] 又は JIS C 61215-2 の 4.13 [高温高湿試験 (MQT 13)] を変更なしで適用する。

6.4.2.4 UV 試験 (MST 54/MQT 10)

IEC 61730-2 の 10.31 [UV test (MST 54)] を変更なしで適用する。

6.4.2.5 低温処理試験 (MST 55)

IEC 61730-2 の 10.32 [Cold conditioning test (MST 55)] を変更なしで適用する。

6.4.2.6 乾燥高温処理試験 (MST 56)

IEC 61730-2 の 10.33 [Dry heat conditioning test (MST 56)] を変更なしで適用する。

6.4.3 一般検査

IEC 61730-2 の 4.3 (General inspection tests) を変更なしで適用する。

6.4.3.1 目視検査 (MST 01/MQT 01)

IEC 61730-2 の 10.2 [Visual inspection (MST 01)] を変更なしで適用する。

6.4.3.2 基準状態 (STC) における性能試験 (MSPT 02/MQPT 06)

この文書の 6.2.5 を参照し、適用する。

6.4.3.3 絶縁層の厚さ試験 (MST 04)

IEC 61730-2 の 10.5 [Insulation thickness test (MST 04)] を変更なしで適用する。

6.4.3.4 表示の耐久性試験 (MST 05)

IEC 61730-2 の 10.6 [Durability of markings (MST 05)] を変更なしで適用する。

6.4.3.5 シャープエッジ試験 (MST 06)

IEC 61730-2 の 10.7 [Sharp edge test (MST 06)] を変更なしで適用する。

6.4.3.6 バイパスダイオード機能試験 (MST 07/MQT 18.2)

IEC 61730-2 の 10.8 [Bypass diode functionality test (MST 07)] 又は JIS C 61215-2 の 4.18.2 [バイパスダイオード機能試験 (MQT 18.2)] を変更なしで適用する。

6.4.4 感電危険試験

IEC 61730-2 の 4.4 (Electrical shock hazard tests) を変更なしで適用する。

6.4.4.1 接近性試験 (MST 11)

IEC 61730-2 の 10.9 [Accessibility test (MST 11)] を変更なしで適用する。

6.4.4.2 切断性試験 (MST 12)

IEC 61730-2 の 10.10 [Cut susceptibility test (MST 12)] を変更なしで適用する。

6.4.4.3 等電位ボンディング連続性試験 (MST 13)

IEC 61730-2 の 10.11 [Continuity test of equipotential bonding (MST 13)] を変更なしで適用する。

6.4.4.4 インパルス電圧試験 (MST 14)

IEC 61730-2 の 10.12 [Impulse voltage test (MST 14)] を変更なしで適用する。

6.4.4.5 絶縁試験 (MST 16/MQT 03)

IEC 61730-2 の 10.13 [Insulation test (MST 16)] 又は JIS C 61215-2 の 4.3 [絶縁試験 (MQT 03)] を変更なしで適用する。

6.4.4.6 湿潤漏れ電流試験 (MST 17/MQT 15)

IEC 61730-2 の 10.14 [Wet leakage current test (MST 17)] を変更なしで適用する。

6.4.4.7 端子強度試験 (MSPT 42/MQPT 14)

IEC 61730-2 の 10.27 [Robustness of terminations test (MST 42)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.5 耐火性試験

6.4.5.1 ホットスポット耐久試験 (MSPT 22/MQPT 09)

IEC 61730-2 の 10.16 [Hot-spot endurance test (MST 22)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.5.2 火災試験 (MSPT 23)

IEC 61730-2 の 10.17 [Fire test (MST 23)] 及び JIS C 8993 をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.5.3 着火性試験 (MSPT 24)

IEC 61730-2 の 10.18 [Ignitability test (MST 24)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.5.4 バイパスダイオード温度試験 (MSPT 25/MQPT 18.1)

IEC 61730-2 の 10.19 [Bypass diode thermal test (MST 25)] 又は JIS C 61215-2 の 4.18.1 [バイパスダイオード温度試験 (MQT 18.1)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.5.5 逆電流過負荷試験 (MSPT 26)

IEC 61730-2 の 10.20 [Reverse current overload test (MST 26)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6 機械的ストレス試験

6.4.6.1 衝撃破壊試験 (MSPT 32)

IEC 61730-2 の 10.21 [Module breakage test (MST 32)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6.2 ねじ込み式接続試験 (MSPT 33)

IEC 61730-2 の 10.22 [Screw connections test (MST 33)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6.3 機械的静荷重試験 (MSPT 34/MQPT 16)

IEC 61730-2 の 10.23 [Static mechanical load test (MST 34)] 又は JIS C 61215-2 の 4.16 [機械的静荷重試験 (MQT 16)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6.4 剥離試験 (MSPT 35)

IEC 61730-2 の 10.24 [Peel test (MST 35)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6.5 せん断強度試験 (MSPT 36)

IEC 61730-2 の 10.25 [Lap shear strength test (MST 36)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6.6 材料クリープ試験 (MSPT 37)

IEC 61730-2 の 10.26 [Materials creep test (MST 37)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

6.4.6.7 端子強度試験 (MSPT 42/MQPT 14)

IEC 61730-2 の 10.27 [Robustness of terminations test (MST 42)] 又は JIS C 61215-2 の 4.14 [端子強度試験 (MQT 14)] をこの文書の 6.4.1 の規定とともに適用する。

7 表示及び文書類

IEC 61730-1 の 6.2 (Marking and documentation) を次の a)及び b)の規定とともに適用する。

- a) IEC 61730-1 の 6.2.2.1 (General) の a)～p)を、銘板に記載する。
- b) IEC 61730-1 の 6.2.3 (Documentation) に、次の項目を加えて規定し、文書類に記載する。文書類を紙で提供する場合も、銘板に付した QR コードなどで情報を取得できるようにする。
 - 1) 最小曲率半径及び／又はモジュールの区分 (フレキシブル PV モジュール, 超フレキシブル PV モジュール, ベンダブル PV モジュールの別)
 - 2) 重量及び外径寸法

次のいずれも記載する。

 - －フレーム, 端子箱を含めた場合 (図 2a 参照) の値
 - －受光面を構成する部材だけとした場合 (図 2b 参照) の値
 - 3) モジュール変換効率

次のいずれも記載する。

 - －外径寸法 (図 2a 参照) 面積で算出した値
 - －実際の発電部寸法 (図 2a 又は図 2b 参照) 面積で算出した値

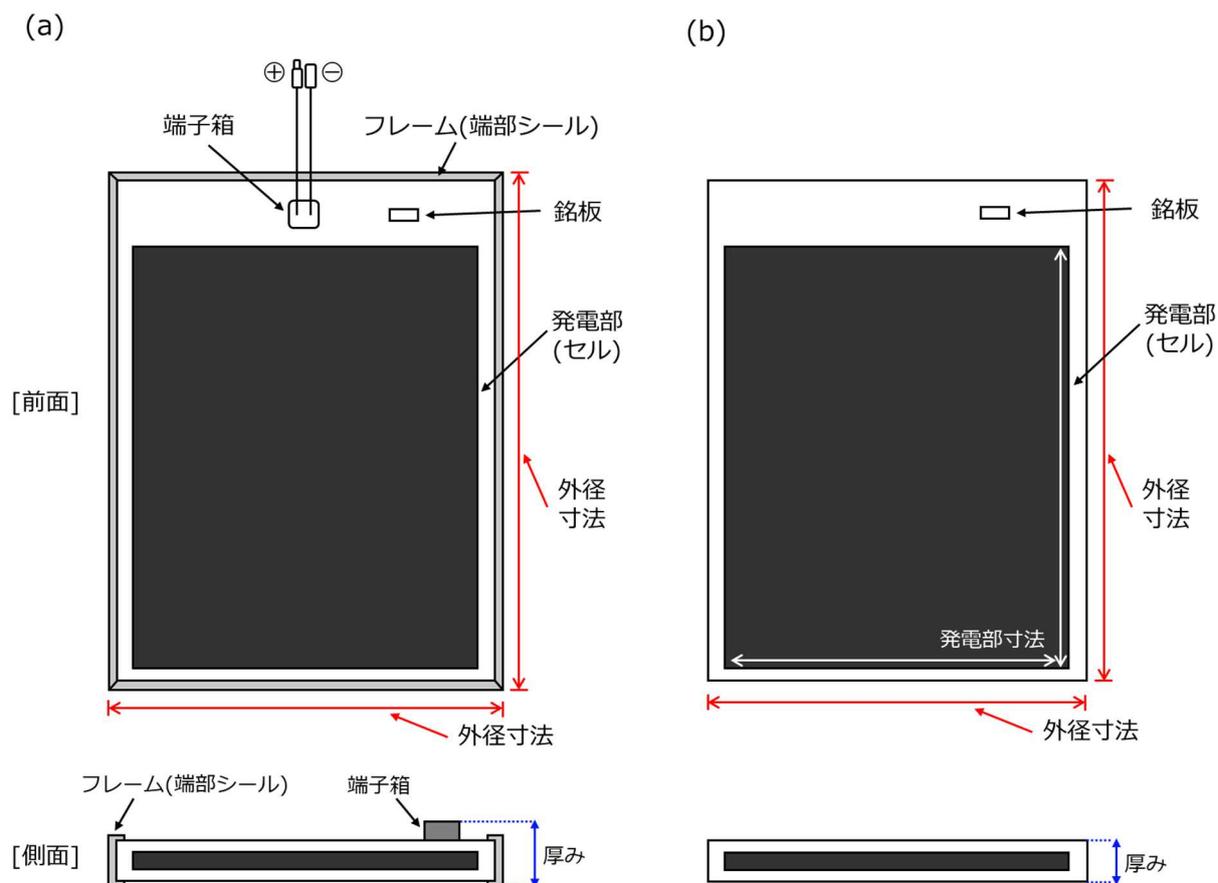


図 2 - (a) PV モジュール及び、(b) 受光面を構成する部材の概略図

- 4) PV モジュールに含まれる環境負荷が懸念される化学物質の種類（鉛、カドミウム、ヒ素、セレン）と単位面積（ 1m^2 ）当たりの含有量（含まれない場合は記載しない）

例 鉛： $0.2\text{g}/\text{m}^2$ 未満

注記 取り付けに係るジグ及び附属品は重量に含まない。

8 サンプリング

JIS C 61215-1 の箇条 4（供試体）及び箇条 9（報告書）に準拠し，試験実施機関が供試体を製造ラインから任意に抜き取り，試験報告書に明記しなければならない。

9 試験の実施

試験は，日本の NCB（National Certification Body）が日本国内において実施しなければならない。

注記 今後，試験機関の拡大を検討する。

附属書 A
(参考)

試験シーケンス用 PV モジュール識別子

試験シーケンス用の PV モジュール識別子について次に示す。

表 A.1 - 試験シーケンス用 PV モジュール識別子

PV モジュール 識別子	試験体の種類	対象基準	試験シーケンス
M1	PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 シーケンス A
M2	フレームなし PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 シーケンス B
M3	PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 シーケンス B1
M4	PV モジュール	IEC 61215 + IEC 61730	IEC 61215 シーケンス C + IEC 61730 シーケンス C
M5	PV モジュール	IEC 61215	IEC 61215 シーケンス C
M6	PV モジュール	IEC 61215 + IEC 61730	IEC 61215 シーケンス E + IEC 61730 シーケンス D
M7	PV モジュール	IEC 61215	IEC 61215 シーケンス E
M8	PV モジュール	IEC 61215 + IEC 61730	IEC 61215 シーケンス D + IEC 61730 シーケンス E
M9	PV モジュール	IEC 61215	61215 シーケンス D
M10	PV モジュール	IEC 61215 + IEC 61730	IEC 61215 シーケンス A + IEC 61730 コントロール
M13	PV モジュール	IEC 61215 + IEC 61730	IEC 61215 シーケンス B + IEC 61730 シーケンス F
M14	フレームなし PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 シーケンス G
M15	PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 衝撃破壊試験
M16	PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 着火性試験
M17	フレームなし PV モジュール	IEC 61730	IEC 61730 はく離試験参照サンプル (該当する場合)
M18	PV モジュール	IEC 61215	61215 シーケンス F
M19	PV モジュール	IEC 61215	61215 シーケンス F
M20	PV モジュール	IEC 61215	61215 シーケンス F
M21	PV モジュール	IEC 61215	61215 シーケンス F
M22	PV モジュール	IEC 61730	火災試験サンプル
M23	PV モジュール	-	比較用サンプル (コントロール)